mi-melektronik

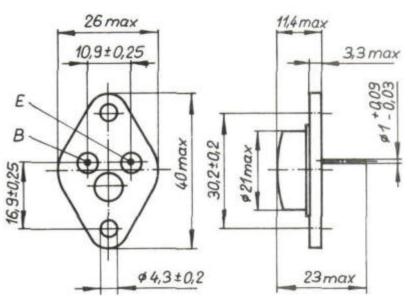
Su 110 11 12



SU 111 - BU 921

Si-npn-Darlingtontransistor für elektronische Zündsysteme

Maße in mm und Anschlußbelegung Masse ca. 22 g Kollektor am Gehäuse



Grenzwerte, gültig für den Betrie	ebstemperaturbereio	h 30441	SU 112
Kollektor-Basis-Spannung $I_{\mathbf{E}} = 0$	UCBO	450 ₹	
Kollektor-Emitter-Spannung IB = 0	CEO 350 V	400 V	4500
Kollektorstrom	IC	10 A	
Kollektorspitzenstrom	I _{CM}	15 A	(4)
Gesamtverlustleistung V _C ≤ 25° C	P _{tot}	120 W	
Sperrschichttemperatur	v _j	175°c	94
Betriebstemperatur	va	125° 0	

Kennwerte, bei 2 = 25°C	rdn	max
Kollektor-Emitter-Reststrom	ICEX	1,0 mA
$U_{BE} = -2V$, $U_{CE} = 450 V$	*	
Kollektor-Emitter-Sättigungs- spannung	UCEsat	1.8 V
$I_C = 7A$, $I_B = 0.14A$	Committee of the Commit	
Basis-Emitter-Sättigungs-	TT	
$I_C = 7A$, $I_B = 0.14A$	UBEsat	2,5 ₹
Kollektor-Emitter-Durchbruchs-	U(DD) 000 400 V	
$I_C = 0.1A$	U(BR)CEO 400 V	
Durchlaßspannung der Freilauf-	77	3.0
diode I _{FM} = 7A	FM	3,0

Bestellbezeichnung: Transistor SU 111

Änderungen vorbehalten !



veb gleichrichterwerk stahnsdorf im veb kombinat mikroelektronik

DDR - 1533 Stahmsdarf, Rühlsdarfer Weg Telex 015220 Teletan 6 80

elektronik export-import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der Deutschen Demokratischen Republik DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6 Haus der Elektroindustrie Telefon: 2180 - Telex: 114721